

IF1322A, IN1322B**N-Channel Matched Dual Silicon Junction Field-Effect Transistor**

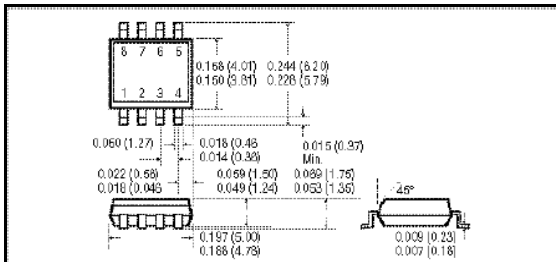
- Low Noise, High Gain Amplifier
- Differential Inputs

Absolute maximum ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage	-20V
Continuous Forward Gate Current	10 mA
Continuous Device Power Dissipation	480mW
Power Derating	3.8 mW/ $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	-65 $^\circ\text{C}$ to +150 $^\circ\text{C}$

At 25 $^\circ\text{C}$ free air temperature Static Electrical Characteristics		IF1322				Process NJ132L	
		Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions	
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS1}$ $V_{(BR)GSS2}$ $V_{(BR)GSS3}$	-20			V	$I_G = -25 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$ $I_G = -3 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$ $I_G = -1 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Fx	$\frac{V_{(BR)GSS1}}{V_{(BR)GSS2}}$	0.9		1.1			
Gate Reverse Current	I_{GSS}			-0.1	nA	$V_{GS} = -10 \text{ V}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	-0.8		-1.5	V	$V_{DS} = 10 \text{ V}, I_D = 1 \mu\text{A}$	
Drain Saturation Current (pulsed)	I_{DSS}	8		25	mA	$V_{DS} = 10 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	
Gate Source Forward Voltage	V_{GSF}	0.3		1.0	V	$V_{DS} = 0 \text{ V}, I_G = -1 \text{ mA}$ $V_{DS} = 0 \text{ V}, I_G = -1 \mu\text{A}$	
Dynamic Electrical Characteristics							
Common-Source Forward Transconductance	g_{fs}	0.01			mS	$V_{DS} = 5 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	1 kHz
Differential Gate Source Voltage-	A	$ V_{GS1} - V_{GS2} $		30	mV	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	
	B	$ V_{GS1} - V_{GS2} $		40	mV	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	
Equivalent Short Circuit Input Noise Voltage ¹	$\sim e_N$			4 2	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	100 hz 1 kHz
Equivalent Short Circuit Input Noise Current ¹	i_n			0.05	pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	1 kHz

Note 1: Guaranteed but not tested.



Dimensions in Inches (mm)

SOIC-8: IF1322
1-G1, 2-D1, 3-S1, 4-G2,
5-G2, 6-D2, 7-S2, 8-G1



715 N. Glenville Dr., Ste. 400
Richardson, TX 75081
(972) 238-9700 Fax (972) 238-5338
www.interfet.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9